

8A、500V N沟道增强型场效应管

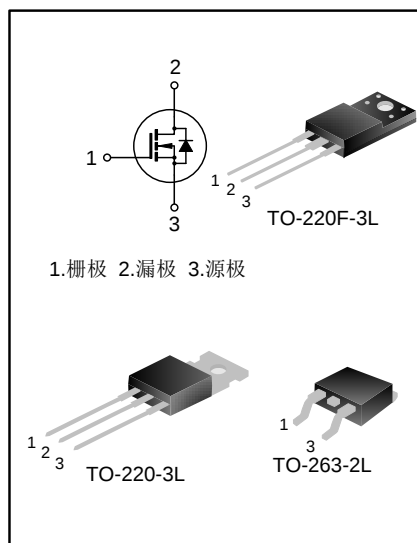
描述

SVD840T/F/S N 沟道增强型高压功率 MOS 场效应晶体管采用士兰微电子的 S-Rin™ 平面高压 VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及条状的原胞设计结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源，DC-DC 电源转换器，高压 H 桥 PWM 马达驱动。

特点

- ◆ 8A，500V， $R_{DS(on)}$ （典型值）=0.62Ω@ $V_{GS}=10V$
- ◆ 低栅极电荷量
- ◆ 低反向传输电容
- ◆ 开关速度快
- ◆ 提升了 dv/dt 能力



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SVD840T	TO-220-3L	SVD840T	无铅	料管
SVD840F	TO-220F-3L	SVD840F	无铅	料管
SVD840S	TO-263-2L	SVD840S	无卤	料管
SVD840STR	TO-263-2L	SVD840S	无卤	编带

极限参数（除非特殊说明， $T_A=25^{\circ}C$ ）

参数		符号	参数值			单位
			SVD840T	SVD840F	SVD840S	
漏源电压		V _{DS}	500			V
栅源电压		V _{GS}	±30			V
漏极电流	T _C =25°C	I _D	8.0			A
	T _C =100°C		5.1			
漏极冲击电流		I _{DM}	32			A
耗散功率（T _C =25°C） - 大于 25°C 每摄氏度减少		P _D	135	49	126	W
			1.08	0.39	1.01	W/°C
单脉冲雪崩能量（注 1）		E _{AS}	686			mJ
工作结温范围		T _J	-55~+150			°C
贮存温度范围		T _{stg}	-55~+150			°C

热阻特性

参数	符 号	参数值			单位
		SVD840T	SVD840F	SVD840S	
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	0.93	2.56	0.99	$^{\circ}C/W$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	62.5	62.5	$^{\circ}C/W$

电性参数（除非特殊说明， $T_J=25^{\circ}C$ ）

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	B_{VDSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	500	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=500V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=4.0A$	--	0.62	0.9	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	--	1186	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	116	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	11	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=250V, I_D=8.0A, R_G=25\Omega$ (注 2, 3)	--	16	--	ns
开启上升时间	t_r		--	33	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	79	--	
关断下降时间	t_f		--	35	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=400V, I_D=8.0A, V_{GS}=10V$ (注 2, 3)	--	31	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	5.6	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	12	--	

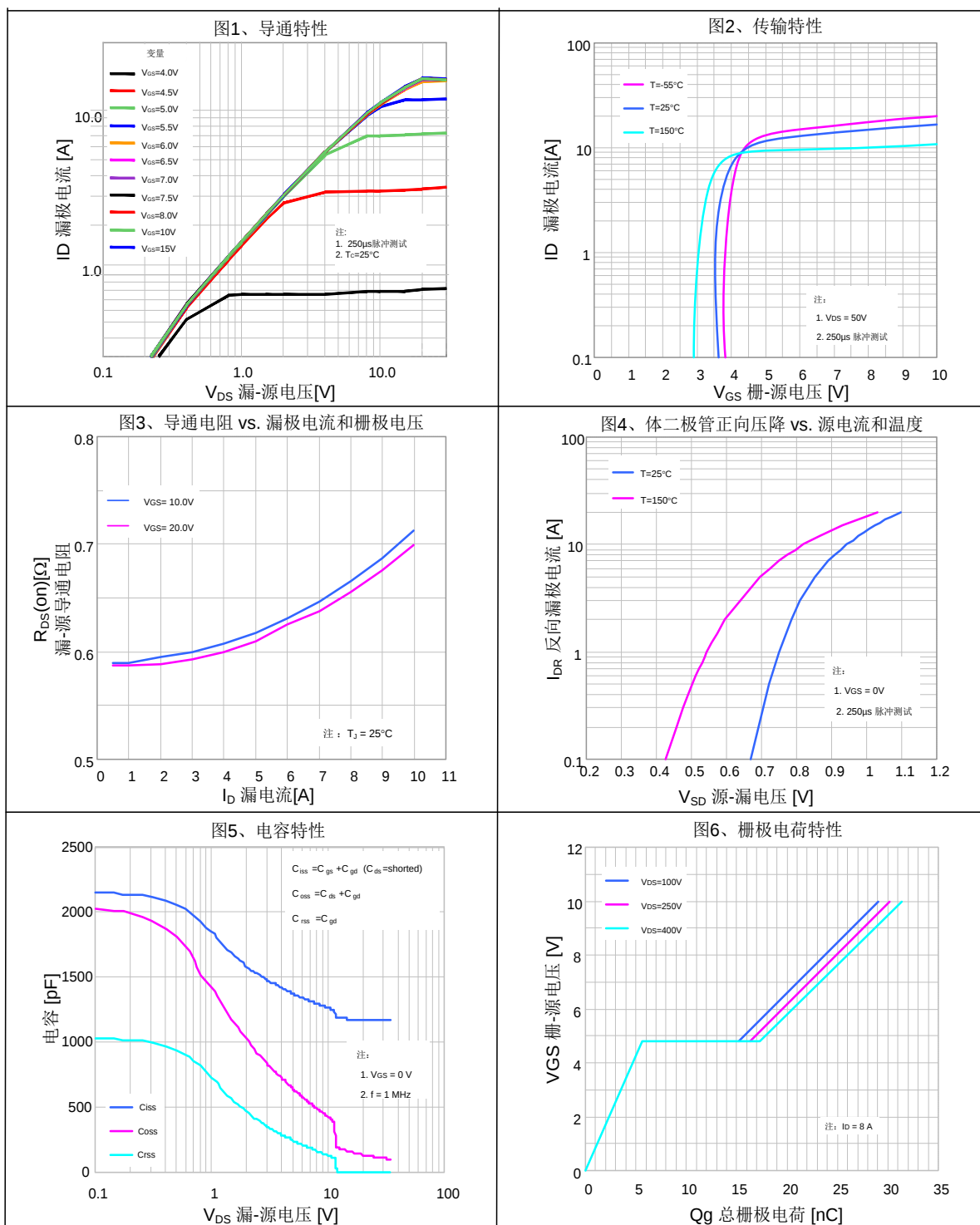
源-漏二极管特性参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	8.0	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	32	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=8.0A, V_{GS}=0V$	--	--	1.5	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=8.0A, V_{GS}=0V, di_f/dt=100A/\mu s$ (注 2)	--	270	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	1.89	--	μC

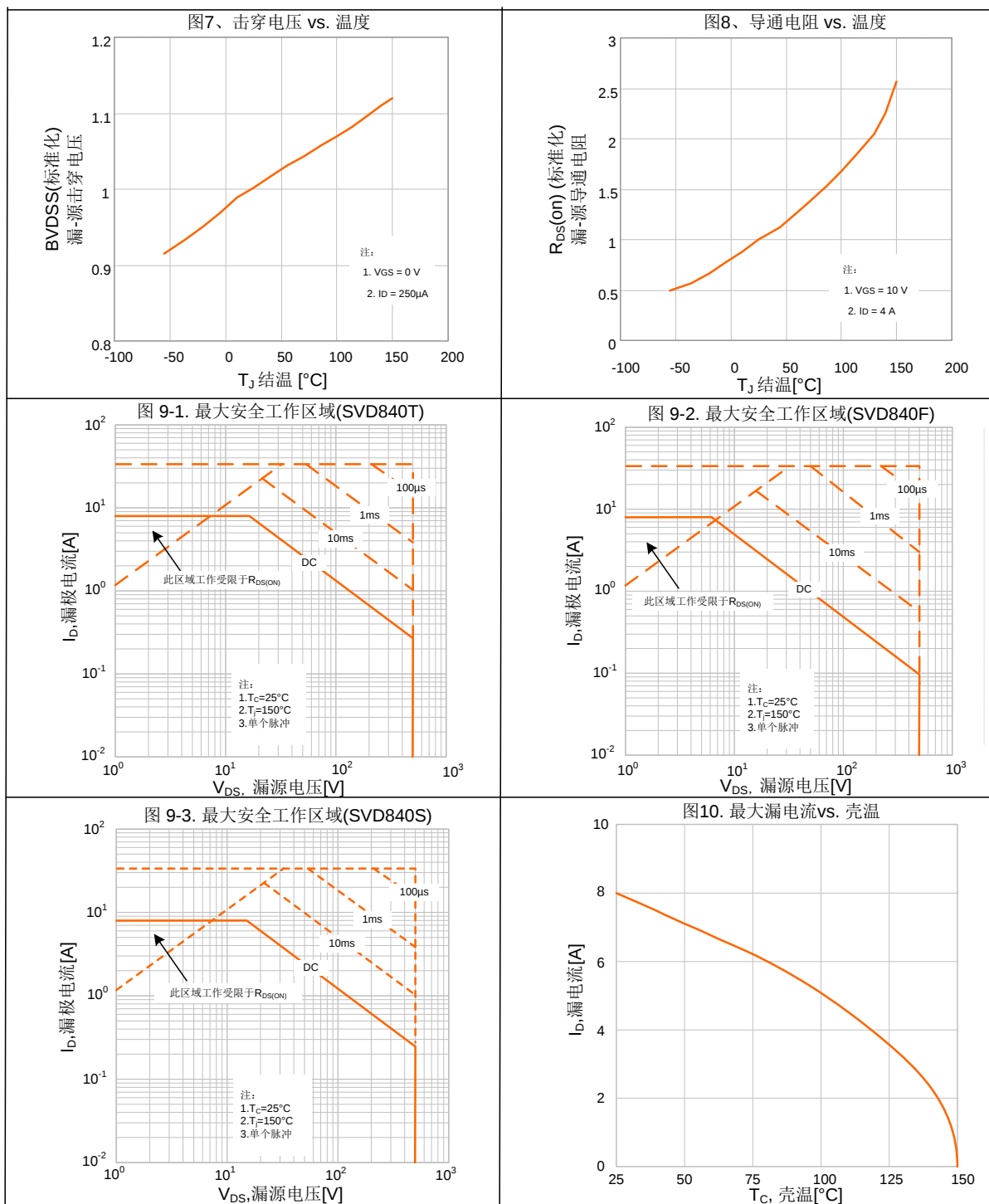
注:

1. $L=30mH, I_{AS}=5.76A, V_{DD}=188V, R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^{\circ}C$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本不受工作温度的影响。

典型特性曲线

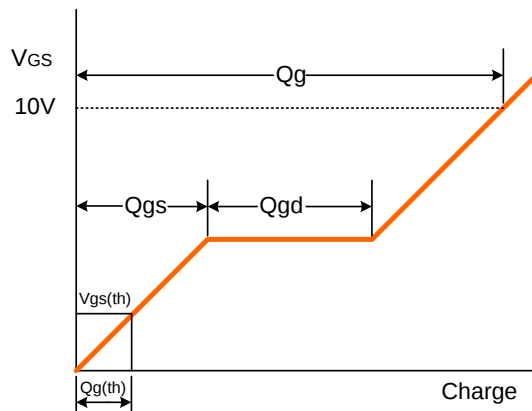
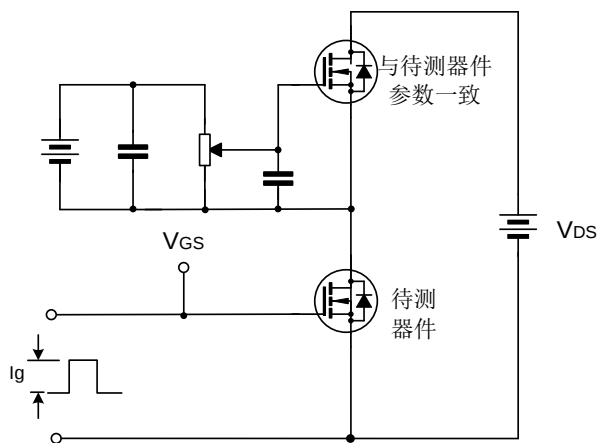


典型特性曲线 (续)

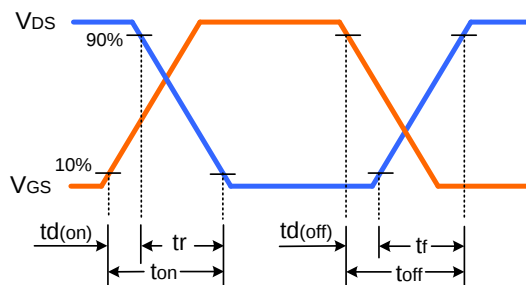
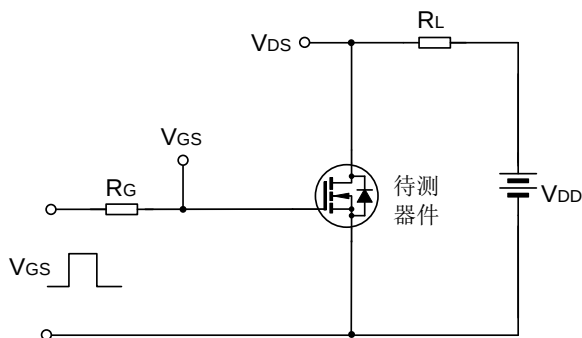


典型测试电路

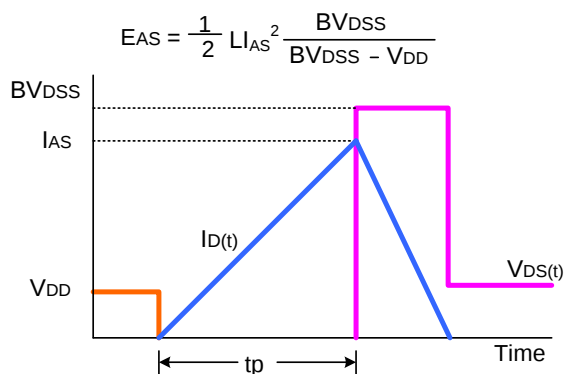
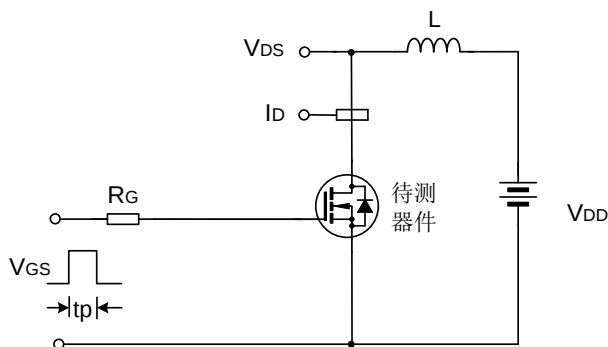
栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图



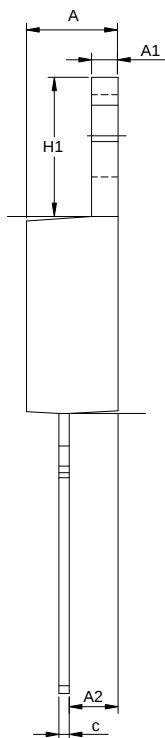
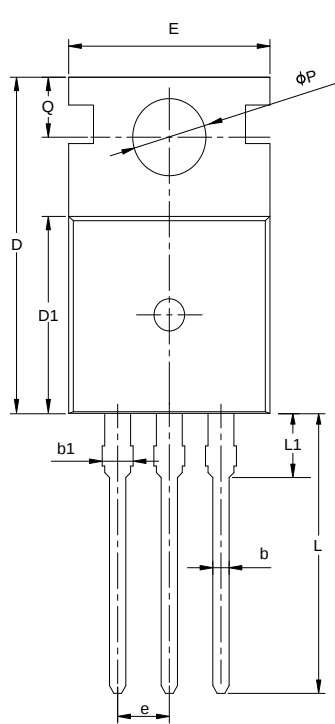
EAS测试电路及波形图



封装外形图

TO-220-3L

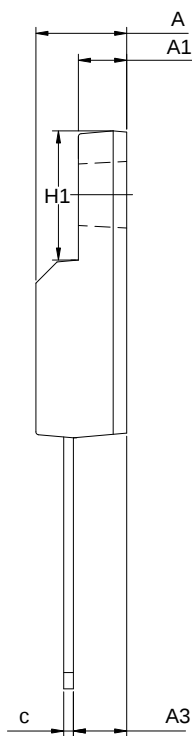
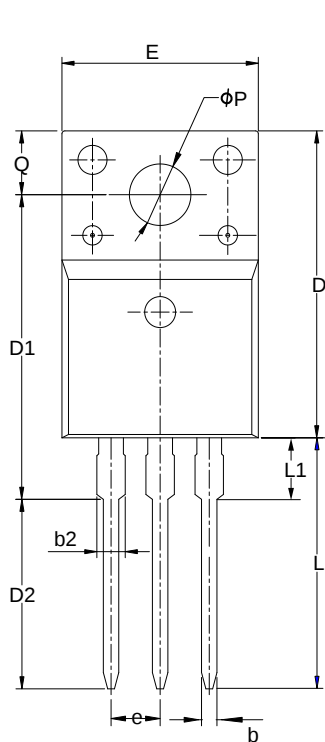
单位：毫米



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.30	4.50	4.70
A1	1.00	1.30	1.50
A2	1.80	2.40	2.80
b	0.60	0.80	1.00
b1	1.00	—	1.60
c	0.30	—	0.70
D	15.10	15.70	16.10
D1	8.10	9.20	10.00
E	9.60	9.90	10.40
e	2.54BSC		
H1	6.10	6.50	7.00
L	12.60	13.08	13.60
L1	—	—	3.95
ϕP	3.40	3.70	3.90
Q	2.60	—	3.20

TO-220F-3L

单位：毫米

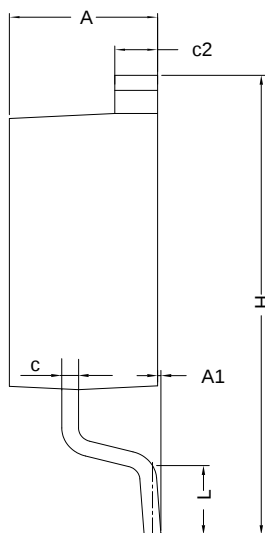
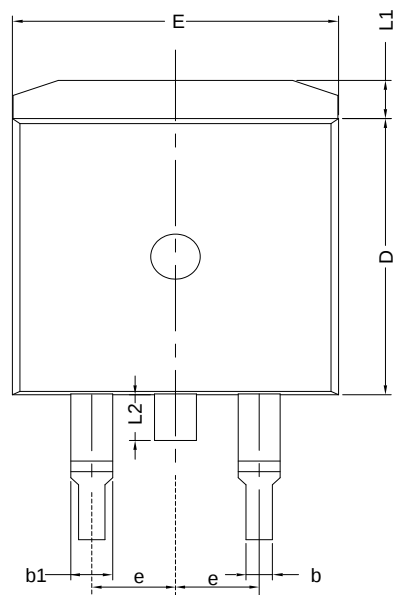


SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.70	0.80	0.90
b2	—	—	1.47
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	15.30	15.75	16.30
D2	9.30	9.80	10.30
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BSC		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	—	—	3.50
ϕP	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

封装外形图（续）

TO-263-2L

单位：毫米



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.30	4.57	4.72
A1	0	0.10	0.25
b	0.71	0.81	0.91
b1	1.17	—	1.50
c	0.30	—	0.60
c2	1.17	1.27	1.37
D	8.50	—	9.35
E	9.80	—	10.45
e	2.54BSC		
H	14.70	—	15.75
L	2.00	2.30	2.74
L1	1.12	1.27	1.42
L2	—	—	1.75

重要注意事项:

1. 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。
2. 客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。产品应用前请仔细阅读说明书，包括其中的电路操作注意事项。
3. 我司产品属于消费类电子产品或其他民用类电子产品。
4. 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值，否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
5. 购买产品时请认清我司商标，如有疑问请与本公司联系。
6. 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！
7. 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

产品名称: SVD840T(F)(S)

文档类型: 说明书

版 权: 杭州士兰微电子股份有限公司

公司主页: <http://www.silan.com.cn>

版 本: 2.2

修改记录:

1. 更新文档模板
2. 更新开关时间
3. 更新电气图和典型电路图
4. 更新封装外形图
5. 更新重要注意事项

版 本: 2.1

修改记录:

1. 修改 TO-220F-3L 封装信息
2. 修改 TO-220-3L 封装信息

版 本: 2.0

修改记录:

1. 修改热阻特性

版 本: 1.9

修改记录:

1. 增加 TO-263-2L 封装

版 本: 1.8

修改记录:

1. 修改产品规格分类

版 本: 1.7

修改记录:

1. 修改 MOS 管符号的示意图

版 本: 1.6

修改记录:

1. 修改“电性参数”、电容特性曲线

版 本: 1.5

修改记录:

1. 修改“封装外形图”

版 本: 1.4

修改记录:

1. 修改“封装外形图”

版 本: 1.3

修改记录:

1. 修改说明书模板

版 本: 1.2

修改记录:

1. 修改“典型特性曲线”

版 本: 1.1

修改记录:

1. 修改耗散功率值、芯片对管壳热阻值
2. 增加 SOA 和 ID-TC 曲线

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式版本发布